

شناسایی نانولایه‌ها با طیف‌سنجی افت انرژی الکترون بازتابی، مطالعه

موردی SrTiO_3 جمیله دریس^۱، شاکر حاجتی^{۱،۲}

گروه فیزیک، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

پژوهشکده نیمه‌هادی‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ویرایش نهائی: ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

چکیده

با تکنیک طیف سنجی افت انرژی الکترون بازتابی (REELS)، در انرژی کم می‌توان خواص الکترونیکی لایه‌های نازک و نانو ساختارها و ساختار الکترونی سطح را تعیین کرد. در این مقاله، با استفاده از سطح مقطع ناکشسان تجربی REELS به‌دست آمده به‌روش توگارد-چورکن دورف، تابع دی الکترونیک تیتانیت استرانسیم با روش یوبرو-توگارد تعیین می‌شود. سطح مقطع تنوری با توافق خوبی با تجربی در انرژی ۱۴۲۳ الکترون ولت و زاویه ورودی و خروجی 35° ، 15° به‌دست آمد. علاوه بر این، توزیع زاویه‌ای پارامتر تحریک پذیری سطح برای این بلور در انرژی‌های ۱۰۰۰، ۱۴۲۳، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ الکترون ولت تعیین شد. در این راستا از تعریف پائولی و توگارد، که به‌عنوان تغییر در احتمال تحریک پذیری یک الکترون که به‌واسطه حضور سطح در مقایسه با الکترون در حال حرکت در محیط نیمه بی‌نهایت است، استفاده شد. محاسبه این پارامتر بر پایه سطح مقطع پاشندگی ناکشسان دیفرانسیلی الکترون، به‌دست آمده از نرم افزار QUEELS، معتبر برای طیف افت انرژی الکترون بازتابی، می‌باشد.

کلیدواژگان: طیف سنجی افت انرژی الکترون بازتابی، تابع دی الکترونیک، پارامتر تحریک پذیری سطح، تیتانیت استرانسیم

مقدمه

فوتوالکترون فرابنفش (UPS)^۱، پراش اشعه ایکس (XRD)^۲، و همچنین تکنیک‌های دیگری وجود دارند که از برانگیختگی غیر ذره‌ای استفاده می‌کنند، مانند میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM). در طیف‌سنجی الکترونی به گسیل و آنالیز الکترون کم انرژی (معمولاً در محدوده ۲۰-۲۰۰۰ الکترون ولت) توجه می‌شود. در گذشته، روش‌های تجربی برای تعیین سطح مقطع پراکندگی ناکشسان الکترون‌هایی که در جامدات حرکت می‌کنند، مبتنی بر عبور الکترون از لایه جامد

تکنیک‌های زیادی ویژه تحلیل سطح وجود دارند که از برانگیزش ذره‌ای استفاده می‌کنند، مانند: طیف‌سنجی الکترون اوژه (AES)^۱، طیف‌سنجی افت انرژی الکترون بازتابی (REELS)^۲، پراش الکترون کم انرژی (LEED)^۳، طیف‌سنجی پس‌پراکندگی رادرفورد (RBS)^۴ و همچنین تکنیک‌هایی که از برانگیزش توسط فوتون استفاده می‌کنند، مانند: طیف‌سنجی فوتو الکترون اشعه ایکس (XPS)^۵، طیف-سنجی

* نویسنده مسئول: Hajati@mail.yu.ac.ir

1- Auger Electron Spectroscopy

2- Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy

3- Low Energy Electron Diffraction

4- Rutherford Backscattering Spectrometry

5- X-ray Photoelectron Spectroscopy

6- Ultra Photoelectron Spectroscopy

7- X-ray photoelectron Diffraction

خیلی نازک بودند [۱]. در چند سال اخیر روش تجربی جدیدی به نام طیف‌سنجی افت انرژی الکترون بازتابی (REELS) برای تعیین سطح مقطع پراکندگی ناکشسان الکترون پیشنهاد شده است که در این روش جدید، سطح مقطع پراکندگی ناکشسان، از توزیع انرژی پرتو تک انرژی الکترون‌هایی که از سطح جامد بازتاب می‌شوند [۲] به دست می‌آید. این آزمایش خیلی ساده است و می‌تواند تقریباً برای هر جامدی به کار برده شود. سطح مقطع پراکندگی ناکشسان الکترون اطلاعاتی را درباره ساختار الکترونیکی سطح جامد در اختیار می‌گذارد، که همچنین یک کمیت مهم در روش QUASES^۱ برای آنالیز غیر مخرب سه بعدی نانو ساختار سطحی توسط XPS و AES می‌باشد. در روش REELS، الکترون‌ها مسافتی را در داخل جامد طی می‌کنند که تعدادی به حلال در جهت تجزیه‌گر انرژی بر می‌گردند. الکترون‌های REELS اولیه ممکن است در طول جابه‌جایی در جامد رویدادهای پراکندگی را تجربه کنند که بسته به خواص اپتیکی و دی‌الکتریک مواد، این رویدادها با هم متفاوت هستند. واکنش با الکترون‌های ناحیه سطح جامد و توزیع انرژی الکترون‌های پس‌پراکنده شده، اطلاعاتی درباره ساختار الکترونیکی و باندهای شیمیایی بیرونی‌ترین نانو لایه در اختیار می‌گذارد. طیف REELS شامل دو ناحیه است: اولی پیک کشسان، که به علت پراکندگی کشسان الکترون‌ها ایجاد می‌شود (الکترون‌ها انرژی از دست نمی‌دهند) و دومی در انرژی‌های جنبشی پایین، برای الکترون‌هایی است که مقداری از انرژی خود را در اثر تحریک‌پذیری سطح جامد از دست می‌دهند. با تغییر انرژی اولیه الکترون‌ها، عمق در حال بررسی تغییر می‌کند و تحریک‌پذیری سطح و توده را می‌توان جداگانه بررسی کرد. طیف‌سنجی افت انرژی الکترون

بازتابی (REELS) در انرژی کم، دارای حساسیت سطحی بالایی است و قادر است که ساختار الکترونی لایه‌های نازک را از طریق تعیین تابع دی‌الکتریک (k)، تعیین کند، چون وقتی که الکترون‌های دارای انرژی در سطح جامد حرکت می‌کنند، الکترون‌های برخوردی می‌توانند به‌طور ناکشسان از طریق واکنش با الکترون‌های ظرفیت و درونی پراکنده شوند [۳، ۴]. برای مطالعه ویژگی‌های دی‌الکتریک نانو ساختارها با استفاده از REELS، برای اینکه مسافت آزاد میانگین ناکشسان الکترون () کمتر از بعد نانو ساختار (چند نانومتر) باشد، انرژی اولیه الکترون باید پایین باشد. به‌طور مثال، در آزمایشات REELS، برای انرژی‌های کمتر از ۵۰۰ الکترون‌ولت، مقدار کمتر از یک نانومتر است. ابتدایی‌ترین مدلی که ارائه شد، ساده‌ترین هندسه احتمالی را ارائه می‌دهد و برای محاسبه افت‌های انرژی توده‌ای به کار می‌رود. چون اغلب، افت‌های توده‌ای (Bulk loss) بیشتر است لذا مدل محیط بی‌نهایت در اکثر حالات تقریب نسبتاً خوبی است. شکل ساده سطح مقطع نهایی به کار برده شده، از مزایای دیگر این مدل به‌شمار می‌رود. توسعه این مدل توصیف خوبی از پراکندگی ناکشسان الکترون در REELS را ارائه می‌دهند که قبلاً توسط توگارد^۲ و کرار^۳ [۵] مطالعه شده است. نتیجه مهم این مطالعه این بود که تقریب محیط بی‌نهایت، برای انرژی‌های بالا ($\geq 5000 \text{ eV}$) معتبر است و در انرژی در حدود ۱۰۰۰ الکترون‌ولت انحرافات وجود دارد. پس از آنها، اثر سطح بر افت انرژی الکترون در حال حرکت در ورقه نازک توسط ریچی^۴ [۶] مطالعه شد.

تیتانیت استرانسیم (SrTiO_3) به‌طور وسیعی در تکنولوژی به کار می‌رود که برای مثال می‌توان کاربردهای آن به‌عنوان بستر یا زیر لایه برای رشد

¹ Quantitative Analysis of Surface Electron Spectra-

² Tougaard

³ Kraaer

⁴ Ritchie

احتمال برای افت انرژی T به‌ازای طول مسیر واحد و به‌ازای افت انرژی واحد تابعی ثابت از T است و مستقل از عمق واقعی زیر سطح جامد است. همچنین فرض می‌شود که برای طول مسیرهای $\{3 \ll R\}$ توزیع طول مسیر R به‌صورت تابع نمایی $\exp(-R/L)$ است که طول واپاشی L می‌تواند مثبت یا منفی باشد. سطح مقطع ناکشسان الکترون تجربی از طیف تجربی REELS به‌صورت زیر تعیین می‌شود:

$$j_L(E) = \frac{\int_{E_0}^{E_0'} K_{\text{exp}}(E_0, E_0 - E) j_L(E') dE'}{\int_{E_0}^{E_0'} j_L(E') dE'} \quad (1)$$

$j_L(E)$ توزیع انرژی اندازه‌گیری شده از الکترون‌های REELS و انتگرال در مخرج، مساحت قله ناکشسان است.

$$\{^* = \} L / (\{ + L) \quad (2)$$

$\{^*$ مسافت آزاد میانگین ناکشسان الکترون است.

تعیین تابع افت انرژی و سطح مقطع پاشندگی ناکشسان نظری از مدل پاسخ تابع دی الکترونیک

اگر تابع افت انرژی (ELF) شناخته شده باشد سطح مقطع پاشندگی ناکشسان نظری K_{th} برای همه الکترون‌های REELS بر مبنای آزمایشات REELS قابل محاسبه است. که در اینجا E_0 انرژی اولیه الکترون و E افت انرژی توسط یک الکترون در پاشندگی ناکشسان است. تابع افت انرژی برحسب نوسانگرهای نوع Drude-Lindhard بسط داده می‌شود.

لایه‌های نازک و همچنین به‌عنوان بلور مناسب گیت دی الکترونیک در وسایل با پایه سیلیکون را برشمرده [۷]. این ساختار همچنین به‌عنوان مواد دی الکترونیک در خازن‌ها، رساناهای یونی اکسیژنی در حسگرها و مواد پیزوالکترونیک در محرک‌ها استفاده می‌شود [۸]، که ضرورت مطالعه این ماده را نمایان می‌کند. در اینجا، این مطالعه با تکنیک طیف سنجی افت انرژی الکترون بازتابی انجام شد. قبلاً، ویژگی‌های دی الکترونیک این بلور با استفاده از طیف سنجی افت انرژی الکترون عبوری (TEELS) اندازه‌گیری شده است. Fabien و همکاران [۹] با استفاده از روش Tougaard-Chorkendorff سطح مقطع پاشندگی ناکشسان منفرد تجربی SrTiO_3 را با اصلاح اثر پاشندگی چندگانه در طیف تجربی REELS به‌دست آوردند. آنها با استفاده از مدلی نظری سطح مقطع پاشندگی منفرد را به‌صورت ترکیب خطی از تابع افت انرژی توده $(-\frac{1}{v})$ و تابع افت انرژی سطح $(-\frac{1}{1+v})$ در نظر گرفتند. این تابع از بسط نوسانگرهای Drude-Loranz به‌دست می‌آید. در این مقاله، سطح مقطع نظری با استفاده از روش ارائه شده توسط Tougaard-Yubero (YT) [۱۰] به‌دست می‌آید، سپس با مقایسه آن با سطح مقطع تجربی تعیین شده به‌روش Tougaard-Chorkendorff، تابع دی الکترونیک محاسبه می‌شود و در نهایت پارامتر تحریک پذیری سطح با استفاده از روش Pauly-Tougaard به‌دست می‌آید [۱۱].

تئوری

تعیین سطح مقطع پاشندگی ناکشسان الکترون از طیف افت انرژی الکترون بازتابی

پرتویی از الکترون با انرژی E_0 به سطح برخورد کرده و توزیع انرژی اندازه‌گیری می‌شود. فرض می‌شود که نمونه همگن است و همین‌طور فرض می‌شود که

پارامتر تحریک پذیری سطح (SEP)

چندین تعریف برای SEP وجود دارد که ما در اینجا از تعریف ارائه شده توسط Pauly و Tougaard استفاده می‌کنیم. تحریک پذیری سطح توسط عبور الکترون از خلأ به جامد و بالعکس ایجاد می‌شود و در حالت کلی تحریک پذیری، به‌عنوان احتمال تحریک پذیری سطح SEP یا $P_s(E, \theta)$ بیان می‌شود و میانگین تحریک پذیری الکترون با انرژی E وقتی که یک بار از سطح در زاویه θ نسبت به عمود بر سطح عبور می‌کند، است. در اینجا ما SEP را از سطوح مقطع دیفرانسیلی پاشندگی ناکشسان محاسبه شده برای REELS با نرم‌افزار QUEELS و QUEELS-REELS با نرم‌افزار $v(k, \tilde{S})$ محاسبه می‌کنیم. از رابطه زیر مسافت آزاد میانگین ناکشسان به‌دست می‌آید:

$$\lambda_{sc} = \left[\int_0^{\infty} K_{sc}(E, \hbar\tilde{S}, \theta_i, \theta_o) d\hbar\tilde{S} \right]^{-1} \quad 6$$

که سطح مقطع پاشندگی ناکشسان با استفاده از نرم‌افزار QUEELS- $v(k, \tilde{S})$ -REELS و با استفاده از بسط تابع دی‌الکترونیک در مدل Drude-Lindhard در معادله ۳ به‌دست می‌آید. اثر سطح به‌صورت زیر تعریف می‌شود

$$k_s = \int (K_{sc} - K_{inf}) d\hbar\tilde{S} \quad 7$$

به‌طوری‌که K_{inf} سطح مقطع پاشندگی ناکشسان توده است. SEP برای الکترون دو بار عبور کرده از سطح به‌صورت زیر است

$$P_s(E, \theta_i) + P_s(E, \theta_o) = \lambda_{sc} K_s \quad 8$$

در محاسبات همیشه زاویه ورودی ثابت فرض می‌شود و SEP برحسب زوایای خروجی به‌دست می‌آید. برای مثال برای $\theta_i = 45^\circ$

$$P_s(E, 45) = \frac{1}{2} \lambda_{sc}(E, 45, 45) K_s(E, 45, 45) \quad 9$$

$$\text{Im} \left\{ -\frac{1}{v(k, \Delta E)} \right\} = \quad 3$$

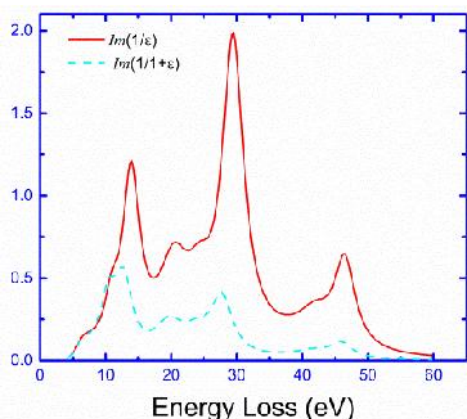
$$\sum_{i=1}^n \frac{A_i X_i \Delta E}{((\hbar\tilde{S}_{0ik})^2 - \Delta E^2)^2 + X_i^2 \Delta E^2} \times \theta (\Delta E - E_g)$$

$$\hbar\tilde{S}_{0ik} = \hbar\tilde{S}_{0i} + r_i \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad 4$$

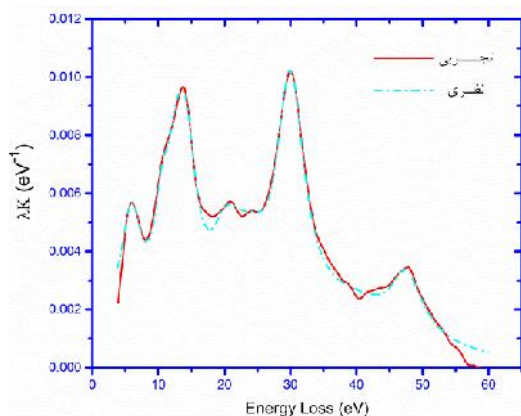
که پارامترهای $A_i, X_i, \tilde{S}_{0ik}$ و r_i به‌ترتیب قدرت نوسانگر، ضرایب میرایی، انرژی برانگیختگی، ضریب پاشندگی تکانه نوسانگر i است. $\hbar k$ تکانه انتقال یافته از الکترون‌های REELS به جامد است. $(\Delta E - E_g)$ تابع پله‌ای، E_g گاف نوار در نیم‌رساناها و عایق‌ها است که برای $\Delta E < E_g$ ، $(\Delta E - E_g) = 0$ و برای $\Delta E > E_g$ ، $(\Delta E - E_g) = 1$ می‌باشد. وابستگی \tilde{S}_{0ik} به k به‌طور کلی شناخته شده نیست. اما ما از معادله ۴ با پارامتر تعدیل r_i استفاده می‌کنیم. مقادیر ضرایب پاشندگی تکانه r_i به جرم مؤثر الکترون وابسته است. به‌همین خاطر برای الکترون آزاد $r_i = 1$ و برای باندهای با انرژی پهن $r_i = 0$ است. روش کار چنین است که ابتدا با استفاده از سطح مقطع ناکشسان تجربی تعیین‌شده، پارامترهای معادله ۳ را به‌دست آورده و به‌عنوان تابع آزمایشی در محاسبه K_{th} استفاده می‌شود. سطح مقطع پاشندگی ناکشسان مؤثر K_{eff} برای الکترون منفرد REELS بر اساس تابعی با انرژی اولیه E_0 ، تابع دی‌الکترونیک سیستم $v(k, \tilde{S})$ ، x_0 بیشینه عمقی که الکترون قبل از پاشندگی کشسان طی می‌کند، θ_i زاویه ورودی و θ_o زاویه خروجی الکترون نسبت به عمود به سطح است، که توسط Yubero-Tougaard [۱۲] محاسبه شده است.

$$K_{th} = \frac{\int_0^{\infty} dx Q(E_0, x, \theta_i, \theta_o) K_{eff}(E_0, \Delta E, x_0, \theta_i, \theta_o)}{\int dx Q(E_0, x, \theta_i, \theta_o)} \quad 5$$

که Q تابع توزیع طول مسیر برای آن الکترون‌هایی که تحت یک برخورد ناکشسان است.



شکل ۱. تابع افت انرژی با استفاده از پارامترهای تعیین شده.



شکل ۲. سطح مقطع تجربی و نظری.

شکل ۲ سطح مقطع تجربی و نظری به‌نحی دیگر شده را نمایش می‌دهد. ملاحظه می‌شود که توافق خوبی بین این دو وجود دارد. توزیع زاویه‌ای SEP را با استفاده از معادله ۱۰ برای بلور مورد نظر محاسبه کرده‌ایم. نتایج برحسب تابعی از θ برای انرژی‌های ۱۰۰۰، ۱۴۲۳، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ الکترون ولت در شکل ۳ به نمایش در آمده‌اند.

در کاربرد تجربی توزیع‌های SEP با معادلات ساده وابسته به زاویه θ و انرژی E و پارامترهای وابسته به ماده برازش می‌شوند. در محاسبات انجام شده، SEP را با نتایج حاصل از محاسبات Oswald تعدیل شده توسط Werner با یک پارامتر وابسته به ماده a برازش کرده‌ایم.

$$P_s(E, \theta) = \frac{1}{0.173a\sqrt{E} \cos \theta + 1} \quad 11$$

که SEP عبوری از سطح منفرد به صورت زیر به دست می‌آید.

$$p_s(E, \theta) = \int_{sc} \{ K_s(E, 45, \theta) - P_s(E, 45) \} \quad 10$$

نتایج و بحث

در محاسبات با کمک نرم‌افزار QUASES-XS REELS از طیف تجربی K_{exp} و با استفاده از نرم‌افزار REELS- $v(k, \tilde{S})$ تابع افت انرژی (ELF) مواد و همچنین سطح مقطع نظری K_{th} را به دست آوردیم. با توجه به شکل سطح مقطع تجربی به دست آمده از طیف REELS، یک تابع افت انرژی آزمون برای $SrTiO_3$ در نظر می‌گیریم. سپس تابع افت انرژی را اصلاح می‌کنیم تا بین سطح مقطع نظری و تجربی هماهنگی ایجاد شود. مقادیر عددی ELF تیتانیت استرانسیم در جدول ۱ و نمودار حاصل از آنها در شکل ۱ ارائه شده‌اند.

جدول ۱. پارامترهای تعیین شده تابع افت انرژی.

i	$\hbar\tilde{S}_{0i}(ev)$	$A_i(ev^2)$	$x_i(ev)$	Γ
۱	۶،۶	۱،۲۵	۳،۷	۰،۰۵
۲	۱۱	۱،۵۳	۲،۷	۰،۸۸
۳	۱۴،۲	۱۴،۵	۳،۳	۰،۰۶۳
۴	۲۰،۷	۱۴،۲	۵،۷	۰،۰۲۸
۵	۱۴،۳	۱۰	۵،۴	۰،۰۳۳
۶	۳۰	۴۲	۴،۶	۰،۰۰۱۵
۷	۳۹	۱۲	۱۲	۰،۰۰۰۶
۸	۴۲،۲	۱۱،۵	۱۱	۰،۰۰۰۱
۹	۴۷،۳	۳۵	۵،۲	۰،۰۵۴

و توگارد [۱۱] با در نظر گرفتن اثر انرژی گاف در محاسبه a به معادله زیر رسیده‌اند.

$$a_{PT} = 0.039\hbar\Omega_p + 0.4 + 0.22E_G \quad ۱۳$$

E_G انرژی گاف است و a_{PT} در حدود ۱٫۹۹ به دست آمد. مقادیر عددی به دست آمده در جدول ۲ ارائه شده است که a_{PT} به دست آمده به نتایج حاصل از محاسبات ما نزدیک است. اختلاف اندک a به دست آمده توسط ما با مقدار a_{PT} را می‌توان به نقص در بلور و تأثیر آن در نتایج تجربی نسبت داد.

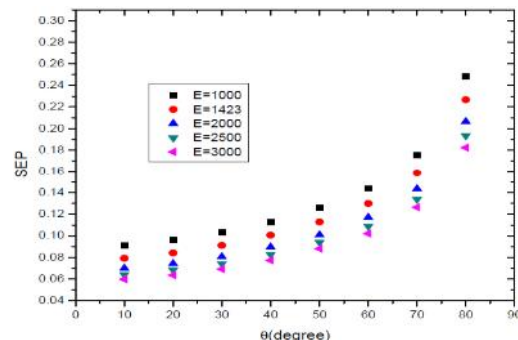
جدول ۲. مقادیر عددی به دست آمده از محاسبات ما و مقادیر برازش شده با معادلات ۱۲ و ۱۳.

	a این کار	a_w	a_{PT}
SrTiO ₃	۱٫۸۸	۱٫۲	۱٫۹۹

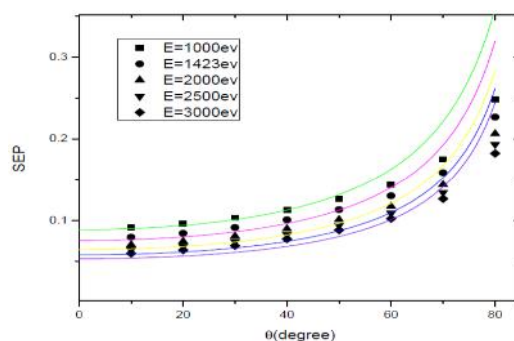
نتیجه‌گیری

در این مقاله خواص دی‌الکتریک تیتانیت استرانسیم با استفاده از مدل YT به دست آمد و مشاهده شد که بین سطح مقطع تجربی و نظری هماهنگی خوبی وجود دارد. از این مدل می‌توان برای تعیین خواص دی‌الکتریک نانولایه‌ها و نانو ساختارها استفاده کرد. همچنین پارامتر تحریک پذیری سطح (SEP) برای این بلور در انرژی‌های متفاوت به روش پاؤلی و توگارد [۱۱] محاسبه و ملاحظه شد که با افزایش انرژی این پارامتر کاهش می‌یابد. در پایان SEP با معادله Werner برازش شد و با مقایسه مقدار a به دست آمده با مقدار a_w و a_{PT} ، مشاهده شد که بین a و a_{PT} هماهنگی خوبی وجود دارد. اصلاح اثر SEP در طیف‌سنجی الکترونی می‌تواند دقت این طیف‌سنجی‌ها را بالاتر ببرد. بنابراین نتایج این مقاله جهت ایجاد یک بانک داده

در رابطه فوق E برحسب الکترون ولت (eV) و ضریب $۰٫۱۷۳$ برحسب $eV^{-1/2}$ و a بدون دیمانسیون است. نتایج حاصل در شکل ۴ نمایش داده شده است. ملاحظه می‌شود که بین محاسبات و برازش با معادله ۱۲ هماهنگی وجود دارد.



شکل ۳. توزیع زاویه‌ای SEP.



شکل ۴. توزیع زاویه‌ای SEP محاسبه شده از مدل Pauly و Tougaard برازش‌های انجام شده با معادلات ۱۳ و ۱۴.

مقدار عددی به دست آمده ۱٫۸۸ است که در ادامه محاسبات به مقایسه این پارامتر با مقدار به دست آمده از فرمول Werner که a_w نامیده می‌شود، پرداخته شده است.

$$a_w = 0.039\hbar\Omega_p + 0.4 \quad ۱۲$$

که در آن $\hbar\Omega_p$ انرژی پلاسمون است، که طریقه به دست آوردن انرژی پلاسمون در مرجع [۱۳] آمده است. a_w در حدود ۱٫۲ است. از آنجایی که در معادله Werner اثر انرژی گاف در نظر گرفته نشده است، مشاهده می‌شود که نتایج به دست آمده از محاسبات ما متفاوت از مقدار محاسبه شده از معادله ۱۲ است. پاؤلی

and theory, *Journal of Applied Physics* **90** (2001) 6156-6164.

[9] F. Paumier, V. Fouquet, M.J. Guittet, M. Gautier-Soyer, R.H. French, G. Tan, Y.M. Chiang, M. Tang, A. Ramos, S.Y. Chung, Reflection electron energy loss spectroscopy of nanometric oxide layers and of their interfaces with a substrate, *Materials Science and Engineering A* **422** (2006) 29–40.

[10] F. Yubero, J.M. Sanz, B. Ramskov, S. Tougaard, Model for quantitative analysis of reflection-electron-energy-loss spectra: Angular dependence, *Physical Review B* **53** (1996) 9719-9727.

[11] N. Pully, S. Tougaard, Theoretical determination of the surface excitation parameter for Ti, Fe, Cu, Pd, Ag, and Au, *Surface Science* **601** (2007) 5611-5615.

[12] F. Yubero, S. Tougaard, Quantitative Analysis of Reflection Electron Energy-loss Spectra, *Surface and Interface Analysis* **19**, (1992) 269-273.

[13] B. Lesiak, A. Kosinski, Influence of Recoil Effect and Surface Excitations on the Inelastic Mean Free Paths of Electrons in Polymers, *Acta Physics A* **109** (2006) 789-800.

برای مواد مختلف می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

سپاس‌گزاری

از سون توگارد (از دانشگاه SDU دانمارک) به‌خاطر در اختیار قرار دادن نرم‌افزار مورد استفاده کمال تشکر به‌عمل می‌آید.

مراجع

[1] S. Tougaard, F. Yubero, Ver 1.2, QUASES, 1998-2004, Software for Quantitative REELS and Determination of Inelastic Electron scattering Cross Sections.

[2] G.L. Tan, L.K. Denoyer, R.H. French, A. Ramos, M. Gautier-Soyer, Y.M. Chiang, *Materials Research Society Symposium Proceedings* **178** (2004).

[3] R.F. Egerton, *Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscopy*. 2nd ed. New York: Plenum, (1996).

[4] S. Hajati, *Quantitative Electron Spectroscopy of Nanostructures; REELS, dielectric properties, XPS, composition and nano-imaging*, (2009) Thesis.

[5] S. Tougaard, J. Kraaer, Inelastic-electron-scattering cross sections for Si, Cu, Ag, Au, Ti, Fe, and Pd, *Physical Review B* **43** (1991) 1651-1661.

[6] R.H. Ritchie, Plasma Losses by Fast Electrons in Thin Films, *Physical Review* **106** (1957) 874-881.

[7] C.H. Lanier, A. Van de walle, Atomic-scale structure of the SrTiO₃(001)-c(6×2) reconstruction: Experiments and first-principles calculations, *Physical Review B* **76** (2007) 045421.

[8] K. Van Benthemand, C. Elasser, Bulk electronic structure of SrTiO₃: Experiment

Characterization of nanofilms by reflection electron energy loss spectroscopy: A study of SrTiO₃

Jamileh Deris¹, Shaaker Hajati^{*,1,2}

¹Department of Physics, Yasouj University, Yasouj, Iran

²Department of Semiconductors, Materials and Energy Research Center (MERC), Karaj, Iran

Received: 29.02.2016 Final revised: 01.04.2017 Accepted: 01.05.2017

Abstract

The electronic properties of thin films and nanostructures as well as the surface electronic structure can be obtained using reflection electron energy loss technique at low energy. In this study, dielectric function of SrTiO₃ is obtained by Yubero-Tougaard method using the experimental inelastic cross section obtained by Tougaard-Chorkrndorf method. Theoretical cross section obtained at energy 1423 eV, incidence angle 15° and exit angle 35° was found to be in good consistency with experimental cross section. In addition, the angular distribution of the surface excitation parameter for this crystal was determined at energies 1000, 1423, 2000, 2500 and 3000 eV. To this end, the definition presented by Pauly and Tougaard was used which relies on the variation in excitation probability at surface and moving in semi-infinite medium. This parameter was calculated based on the differential inelastic electron dispersion cross section using QUEELS software, which is valid for reflection electron energy loss spectrum.

Keywords: Reflection electron energy loss spectroscopy, SrTiO₃, Dielectric function, Surface excitation parameters

*Corresponding Author: Hajati@mail.yu.ac.ir